



PNP type

PNP エピタキシャルプレーナ型

シリコントランジスタ

トランジスタ

低周波増幅用

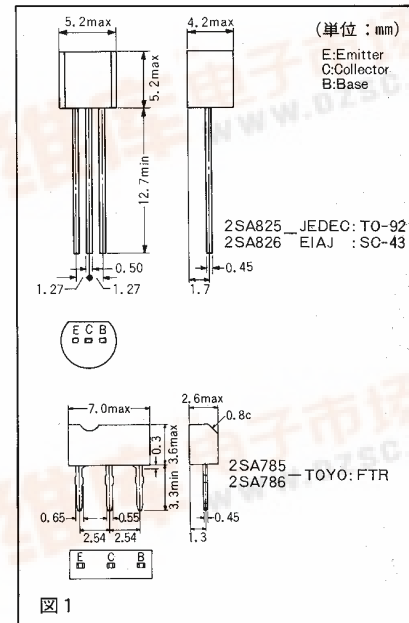
■ 絶対最大定格 (Ta=25°C) (Absolute Maximum Ratings)

項	目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース電圧	2SA785, 2SA825	V _{CB0}	-80	V
	2SA786, 2SA826		-50	
コレクタ・エミッタ電圧	2SA785, 2SA825	V _{CER}	-80	V
	2SA786, 2SA826	V _{CEO}	-40	
エミッタ・ベース電圧		V _{EBO}	-5	V
コレクタ電流		I _c	-50	mA
コレクタ損失	2SA785, 2SA825	P _c	150	mW
	2SA825, 2SA826		250	
接合部温度		T _j	125	°C
保存温度		T _{stg}	-55~125	°C

■ 電気的特性 (Ta=25°C) (Electrical Characteristics)

項	目	記号	MIN	TYP	MAX	単位	条件
コレクタ・エミッタ降伏電圧	2SA785, 2SA825	BV _{CER}	-80	-	-	V	I _c =-1mA, R _{BE} =10KΩ
	2SA786, 2SA826		BV _{CEO}	-40	-		-
コレクタ・ベース降伏電圧	2SA785, 2SA825	BV _{CB0}	-80	-	-	V	I _c =-50μA
	2SA786, 2SA826		-50	-	-		
エミッタ・ベース降伏電圧		BV _{EBO}	-5	-	-	V	I _E =-50μA
コレクタシャ断電流	2SA785, 2SA825	I _{CB0}	-	-	-1	μA	V _{CB} =-50V
	2SA786, 2SA826		V _{CB} =-30V				
エミッタシャ断電流		I _{EBO}	-	-	-1	μA	V _{EB} =-4.5V
直流電流増幅率		h _{FE}	82	-	270	-	V _{CE} =-3V, I _c =-10mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧		V _{CE (sat)}	-	-	-0.5	V	I _c =-10mA, I _B =-1mA
利得帯域幅積(トランジション周波数)		f _T	-	180	-	MHz	V _{CE} =-5V, I _E =10mA
コレクタ出力容量		C _{ob}	-	6.5	-	pF	V _{CB} =-6V, I _E =0, f=1MHz

■ 外形寸法図 (Physical Dimension)



2SA785 2SA786
2SA825 2SA826

h_{FE}の値により下表のように分類します。

	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

(注) 2SA786および2SA826のh_{FE}範囲は82~390です。

